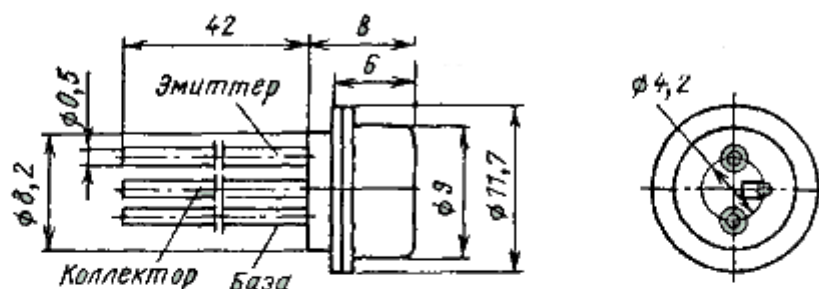


2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г, 2Т603И, КТ603А, КТ603Б, КТ603В, КТ603Г, КТ603Д, КТ603Е

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные *n-p-n* импульсные высокочастотные маломощные

Предназначены для применения в импульсных и переключа-
тельных высокочастотных схемах



Электрические параметры

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер

при $I_K = 150$ мА, $I_B = 15$ мА:

2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г не более 0,8 В

типовое значение 0,2* В

КТ603А, КТ603Б, КТ603В, КТ603Г, КТ603Д, КТ603Е

не более 1,0 В

при $I_K = 350$ мА, $I_B = 50$ мА 2Т603И не более 1,2 В

Напряжение насыщения база-эмиттер:

при $I_K = 150$ мА, $I_B = 15$ мА:

2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г, КТ603А, КТ603Б,

КТ603В, КТ603Г, КТ603Д, КТ603Е не более 1,5 В

типовое значение 0,9* В

при $I_K = 350$ мА, $I_B = 50$ мА 2Т603И не более 1,3 В

типовое значение 1,0* В

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим

эмиттером при $U_{КБ} = 2$ В

при $T = 298$ К:

при $I_3 = 150$ мА,

2Т603А, 2Т603В, КТ603Д 20 — 80

КТ603А, КТ603В 10 — 80

2Т603Б, 2Т603Г 60 — 180

КТ603Б, КТ603Г не менее 60

КТ603Е 60 — 200

при $I_3 = 350$ мА 2Т603И не менее 20

типовое значение 50*

при $T = 213$ К, $I_3 = 150$ мА

2Т603А, 2Т603В	8–80
2Т603Б, 2Т603Г	20–180
2Т603И не менее	8
при $T = 398$ К, $I_3 = 150$ мА	
2Т603А, 2Т603В	20–180
2Т603Б, 2Т603Г	60–400
2Т603И не менее	20
Время рассасывания при $I_K = 150$ мА, $I_B = 15$ мА:	
2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г, 2Т603И не более	70 нс
типовое значение	40* нс
КТ603А, КТ603Б, КТ603В, КТ603Г, КТ603Д, КТ603Е не более	100 нс
Постоянная времени цепи обратной связи при $U_{КЭ} \approx 10$ В, $I_3 = 30$ мА, $f = 5$ МГц не более	
типовое значение	400 пс
	25* пс
Граничная частота передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КЭ} = 10$ В, $I_3 = 30$ мА, не менее	
типовое значение	200 МГц
	370* МГц
Емкость коллекторного перехода при $U_{КЭ} = 10$ В, $f = 5$ МГц не более	
типовое значение	15 пФ
	3* пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{ЭБ} = 0$, $f = 5$ МГц не более	
типовое значение	40 пФ
	35* пФ
Обратный ток коллектора, не более	
при $T = 298$ К при $U_{КБ} = 30$ В	
2Т603А, 2Т603Б, 2Т603И	3 мкА
КТ603А, КТ603Б	10 мкА
при $U_{КБ} = 15$ В	
2Т603В, 2Т603Г	3 мкА
КТ603В, КТ603Г	5 мкА
при $U_{КБ} = 10$ В КТ603Д, КТ603Е	
	1 мкА
при $T = 398$ К	
при $U_{КБ} = 24$ В 2Т603А, 2Т603Б, 2Т603И	60 мкА
при $U_{КБ} = 12$ В 2Т603В, 2Т603Г	60 мкА
Обратный ток эмиттера не более	
при $U_{ЭБ} = 3$ В 2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г, 2Т603А, КТ603Б, КТ603В, КТ603Г, КТ603Д, КТ603Е	
	3 мкА
при $U_{ЭБ} = 4$ В 2Т603И	3 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база и коллектор-эмиттер при $R_{БЭ} \leq 1$ кОм

при $T_n \leq 343$ К

КТ603А, КТ603Б	30 В
КТ603В, КТ603Г	15 В
КТ603Д, КТ603Е	10 В

при $T_n \leq 373$ К

2Т603А, 2Т603Б, 2Т603И	30 В
2Т603В, 2Т603Г	15 В

при $T_n = 393$ К

КТ603А, КТ603Б	15 В
КТ603В, КТ603Г	7,5 В
КТ603Д, КТ603Е	10 В

при $T = 398$ К:

2Т603А, 2Т603Б, 2Т603И	24 В
2Т603В, 2Т603Г	12 В

при $T = 423$ К:

2Т603А, 2Т603Б, 2Т603И	18 В
2Т603В, 2Т603Г	9 В

Напряжение эмиттер-база.

2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г	3 В
2Т603И при $T_n \leq 343$ К	4 В
2Т603И при $T_n = 398$ К	3 В

Постоянный ток коллектора 300 мА

Импульсный ток коллектора при $\tau_n \leq 10$ мкс,

$Q \geq 10$ 600 мА

Постоянная рассеиваемая мощность:

при $T \leq 323$ К 0,5 Вт

при $T = 358$ К КТ603А, КТ603Б, КТ603В,
КТ603Г, КТ603Д, КТ603Е и $T = 398$ К 2Т603А,
2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г, 2Т603И 0,12 Вт